

### 关键指标

频率：DC~12GHz

均衡量：9dB

插入损耗：0.7dB@12GHz

芯片尺寸：0.77mm×0.86mm×0.1mm

### 产品简介

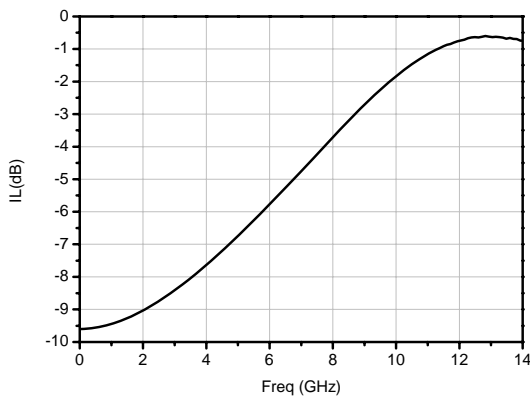
HG115JG-1 是一款 DC~12GHz 均衡器芯片，采用 GaAs pHEMT 工艺制作，均衡量为 9dB，输入输出驻波比为 1.4/1.4。

### 电性能 (T<sub>A</sub>=25℃)

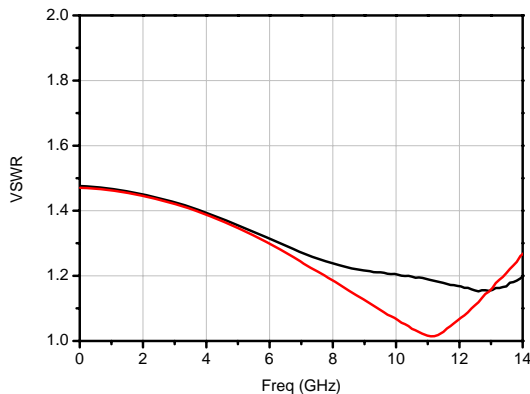
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	DC~12		
输入驻波	-	1.4	-
输出驻波	-	1.4	-
插入损耗(dB)	-	0.7~9.7	-
均衡量(dB)	-	9	-

### 典型测试曲线

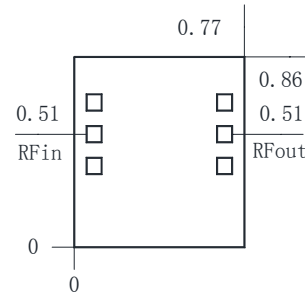
插入损耗



驻波



### 外形和端口尺寸 (mm)



### 绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。